

# 第1回 GaN デバイス研究会 GaN 交流会

2024  
12/18  
wed.

名古屋大学内  
野依記念学術交流館

GaNデバイスのR&Dを加速するための技術情報と議論の場を提供すると共に専門性を深掘りし開発を推進する研究会を開催します。また同時にGaN交流会も開催します。

## 《プログラム》

### GaN デバイス研究会 13:30～16:10

#### 《参加費》

GaNコンソーシアム会員 : 無料  
GaNコンソーシアム会員外 : ¥20,000【税込】

- 【13:00-】 受付
- 【13:30-13:40】 オープニング 研究会の趣旨  
須田 淳 (名古屋大学 教授)  
(GaNコンソーシアム理事)
- 【13:40-14:00】 高周波デバイス国際学会等動向論評  
原 信二 (名古屋大学 特任教授)
- 【14:00-14:20】 光デバイス国際学会等動向論評  
岩谷素顕 (名城大学 教授)  
(GaNコンソーシアム運営幹事会委員)
- 【14:20-14:40】 パワーデバイス国際学会等動向論評  
須田 淳 (同上)
- 【14:40-14:50】 〈休憩〉
- 【14:50-15:10】 C-TEFs紹介  
施設概要  
笹岡千秋 (名古屋大学 特任教授)  
利用事例の紹介  
石田 崇 (株式会社ミライズテクノロジーズ)
- 【15:10-15:30】 招待講演  
「高チャネル移動度GaN MOSFETの研究」  
成田哲生 (株式会社豊田中央研究所)
- 【15:30-16:00】 招待講演  
「GaN MOSデバイスの物理  
-ホールトラップの原子レベルの起源-」  
白石賢二 (名古屋大学 教授)
- 【16:00-16:10】 クロージング

### GaN 交流会 16:30～18:30

#### 《参加費》

GaNコンソーシアム会員 : ¥3,000【税込】  
GaNコンソーシアム会員外 : ¥3,000【税込】

- 【16:30-16:40】 オープニング  
天野 浩 (GaNコンソーシアム代表理事)  
(名古屋大学 教授)
- 【16:40-17:10】 インダストリアルセッション  
ショートプレゼンテーション  
(企業・機関/5分程度)
- 【17:10-18:30】 企業・学生/ポスター展示  
※ショートプレゼンテーション・ポスター展示発表の参加は  
GaNコンソーシアム会員様に限らせていただきます  
※ポスター展示へ参加した学生は参加費は無料とします  
※ポスター展示参加枠は数に限りがございます  
※交流会 (軽食付き)
- 【18:30】 クロージング

研究会・交流会参加  
申込フォーム

申込期限：12月16日(月)



ショートプレゼンテーション

ポスター展示発表

参加申込フォーム

申込は締め切らせて

いただきました



共催

一般社団法人GaNコンソーシアム  
<https://www.gan-conso.jp/>

名古屋大学 未来エレクトロニクス集積研究センター  
<https://www.cirfe.imass.nagoya-u.ac.jp>

会場MAP

